## **EXPOSURE DEVICE**

Publication number: JP57205728

Publication date:

1982-12-16

Inventor:

ARIGA TAKASHI

Applicant:

**FUJITSU LTD** 

Classification:

POSTIOU EID

- international:

G03B27/20; G03F7/20; H01L21/027; H01L21/30;

G03B27/02; G03F7/20; H01L21/02; (IPC1-7):

G03B27/20; G03F7/20

- European:

G03F7/20T24

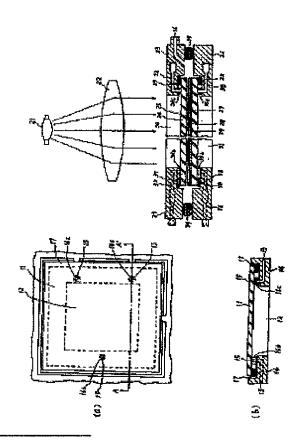
Application number: JP19810091800 19810615 Priority number(s): JP19810091800 19810615

Report a data error here

#### Abstract of JP57205728

PURPOSE:To decrease superposing errors of a working mask by attracting and supporting a photomask or the photomask and a substrate to be exposed at plural points.

CONSTITUTION: A supporting mechanism for a photomask 11 has a light projection window 12 in the central part. It has a mask supporting table 14 formed with holes for evacuation 13 in a frame part, three mask attracting pins 16a, 16b, 16c which are fixed to the peripheral part of the window 12 of the table 14 and have vacuum attraction holes 15 connecting to the holes 13, and a frame-like packing 17 fixed to the table 14 in such a way as to enclose the window 12 on the outer side of the pins 16a-16c. The holes 13 of the table 14 are evacuated to attract and hold a photomask 11 in the region where the flatness is assured, in the peak parts of the pins 16a-16c. Since no strains are generated in the photomask by this, the superposition errors of the working mask are decreased.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭57-205728

⑤Int. Cl.³G 03 B 27/20G 03 F 7/20

識別記号

庁内整理番号 7907-2H 7267-2H 母公開 昭和57年(1982)12月16日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

## **分露光装置**

②特 願 昭56-91800

②出 願 昭56(1981)6月15日

⑫発 明 者 有賀隆

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

邳代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 細 書

- 発明の名称
  第光装置
- 2. 特許請求の範囲
  - フォト・マスク或るいはフォト・マスクと被 酸光素板を、複数点で吸着支持する機構を具備 せしめてなることを特徴とする端光装備。
  - 2. 前記吸着支持する機構が三点で吸着支持する ようにしてなることを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の繋光装置。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は露光装備に係り、特に密治露光装置(コンタクト・ブリンタ)及び近接露光装置(プロキシミティ・プリンタ)に於けるフォト・マスク或るいは被露光基板の支持機解に関する。

半導体集状回路装置(IO)等を製造する際に、 該半導体IOの機能領域や配線パターンの位置及 び形状を規定する複数層のフォト・マスク(ワー キング・マスク)の重ね合わせ精度を高めること が、その製造歩留まりや無彻服を向上せしめるう えで極めて重要なととである。

ワーキング・マスクは一般に高相能に形成されたマスタ・マスクからコンタクト・プリント方式により転写形成される。そして従来のコンタクト・プリンタに於ては、第1図の上面図(a)及びその AーA′矢視断面図(b)に示すように、マスタ・マスク1の固定支持は、マスタ・マスク1の周線部が、マスク支持台2の投光®3周辺部に設けられた実空吸着面4により面吸着されることによってなされていた。(図中、5は真空吸着等、6は真空吸着孔を示す)

一方マスク基板の平面度はその関熱近傍の領域では保証されておらず、高梯度形成されているマスタ・グレードのマスク基板でも10~20[µm]程度の凹凸を有している。そのためマスタ・マスクをその全角縁部に於て面吸着する方式のマスク支持機構を有するコンタクト・ブリンタに於ては、マスク周縁部の凹凸のためにマスタ・マスクが歪んで支持固定されるので、酸マスタ・マスクから数写形成されたワーキング・マスクのパターンも

並んだパターンとなり、複数機のワーキング・マスク間には  $1(μπ) \sim 2(μm)$  弱程度の重ね合わせずれが生ずるという問題があった。

本発明は上記問題点を除去する目的で、フォト・マスク戦るいは被解光基板を歪めることなく支持できる、解光装置の塞板吸滑支持機構を提供する。

即ち本発射は臨光装置に於て、フォト・マスク 或るいはフォト・マスクと被露光装板を、複数点 特に三点で吸避支持する機構を具備せしめてなる ことを特徴とする。

以下本鉛的を一天液例について、第2図に示すマスク支持機構の上面図(a)、A-A'矢視断面図(b)、及び第3図に示す密着離光表置の断面核式図を用いて評細に説明する。

本発明の臨光装備に於けるフォト・マスク11 の支持機構は、例えば第2図(a)及び向に示すよう に、中央部に牧光級12を有し、枠部に真空孔13 が形成されたマスク支持台14と、該マスク支持 台14の役光総12周辺部に固着され、前距真空

#### - 3 -

されている領域で吸着固持するので、フォト・マスク11に歪みを発生させることがない。なおこのようにフォト・マスク11を吸着固持した状態に於て、前記マスク吸着ピン16a、16b、16cの高さより厚くした枠状パッキン17はフォト・マスク11に密着し、フォト・マスク11の上面と下面の削を気密に略離する。

第3 図は上記突施例に示したマスク支持機構と 同様のマスク支持機構を具備せしめた密着解光装 能に戻ける一例の概要を示したもので、図中21 は光源、22は光学系、23はマスタ・マスク支 持台、24はマスタ・マスク、25はマスク・パ ターン、26は被解光基板支持台、27は未解光 ワーキング・マスク基板、28はフォト・レジス ト層、29は遮光膜、30、31は投光線、32、 83は真空孔、34b、34c、35b、35cはマスク 吸着ピン、36は密着用排気孔、37、38、39は パッキンを表わしている。

散密確露光装置を用いて、マスタ・マスクから バターンの転写を行ってワーキング・マスクを形 孔13に接続する真空吸濫孔15を有する3(本) のマスク吸着ピン16a、16b、16cと、これらマ スク吸着ピン 16a、16b、16cの外側に投光器12 を囲むようにマスク支持台14とに固難された枠 秋パッキン17を有してなっている。そして前能 マスク数着ピン 16a、16b、16c は可塑性の小さ い樹脂材料、例えばテフロン等により2~3(mm) 程度の高さに形成され、投光燃12周辺部に於け るフォト・マスク11(マスク・基板)の平面度 が保証される領域、即ちフェト・マスク11の周 級部から 6~7(mm) 程度以上内側の領域上に、例 えば投光器の一辺に沿って2(本)対向辺に沿って 1[本]配設される。又敵配砕状パッキン17は可 **盟性の大きい樹脂材料、例えばシリコン・ゴム、** オオプレン等からなる前記マスク吸滑ビン16a、 16b、16cの高さより僅かに厚めのものを用いる。 影フェト・マスク支持機械になては、マスク支持 台14の真空孔13を真空に排気することにより、 3[本]のマスク吸着ビン16a、16b、16cの頂部 に於てフォト・マスク11を、その平面度が保証

#### - 4 --

成する祭には、マスタ・マスク支持台23に前述した手段によりマスク・パターン25面を下に向けてマスタ・マスク24を吸引固持せしめ、一方被解光基板支持台26に同様の手段により未解光のワーキング・マスク基板27を、フォト・レジスト勝28を有する面を上にして吸引固持せしめる。そして酸マスタ・マスク支持台23と被解光基板支持台26を流が中ン37、38、39によって形成される全域圧することによりマスタ・マスク24と未解光ワーキング・マスク基板27とを発着せしめて発発により解光を行う。

なお上記実施例に於ては、マスタ・マスク及び 被露光基板を本発明のマスク支持機構を具備する 支持台に吸引固持したが、マスク基板の平面度が より高品位(±3(Am)以下)なマスタ・マスク のみを本発明の機構により支持した際にも、光分

特開昭57-205728(3)

な効果が得られ、本発明のマスク支持機構を具備 した密灣露光装置を用いて形成したワーキング・ マスクの重ね合わせ観差は 0.5 ( µm ) 以下であっ tc 0

また上記実施例では3本のマスク吸贈ピンで吸 灘支持しているが、4本、5本等の複数本のマス ク吸激ピンでも同様の効果を得ることはできる。 ただし 4 本、 5 本…の場合に比べて、 3 本の場合 の方が歪んで支持間定されることを防止する効果 は大である。

又本発明のマスク支持機構は近接襲光装置にも 有効である。

以上説明したように本発明によればワーキング ・マスクの重ね合わせ誤差が減少するので、半導 体IOの製造歩留まりや集秋度の向上が図れる。

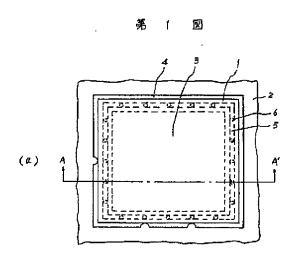
### 4. 匈衙の簡単な説明

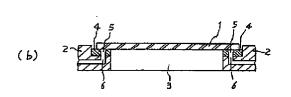
第1図は従来のマスク支持機構の上面図(a)及び A-A' 矢視斯面図(b)、第2図は本発明の一実施 例に於けるマスク支持機構の上面図(a)及びA-A' 矢福樹面図(b)、第3図は本発明の密着観光装置に 於ける一実施例の断面模式図である。

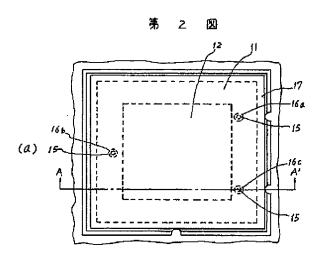
図に於て、11はフォト・マスク、12は投光 窓、13は真空孔、14はマスク支持台、15は 真空吸着孔、16a、16b、16cはマスク吸着ピン、 17は枠状パッキンを示す。

代理人 弁理士

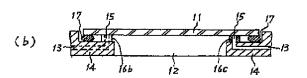








- 8 --



# 第 3 図

